



Общероссийский математический портал

Н. Г. Басов, О. Н. Крохин, Жорес Иванович Алферов — лауреат Нобелевской премии по физике за 2000 г., *Квантовая электроника*, 2000, том 30, номер 11, 1034

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением
<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 18.97.14.86

16 марта 2025 г., 03:12:14





Жорес Иванович Алферов – лауреат Нобелевской премии по физике за 2000 г.

Решением Королевской Академии наук Швеции Нобелевская премия по физике за 2000-й год присуждена Ж.И.Алферову (Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, С.-Петербург, Россия) и Герберту Кремеру (Калифорнийский университет, Санта-Барбара, США) за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокоскоростной электронике и оптоэлектронике, а также Джеку С.Килби («Тексас Инструментс», Даллас, США) за его вклад в создание интегральных схем.

Работы Ж.И.Алферова и его школы в области физики, техники и технологии полупроводников и полупроводниковых приборов оказали огромное влияние на развитие физики и техники диодных лазеров. Созданные им гетероструктуры, первый гетеролазер, работающий в непрерывном режиме при комнатной температуре, по существу проложили путь быстрому превращению уникального физического устройства – полупроводникового лазера – в массовое изделие современной техники – лазерный диод. В последнее десятилетие полупроводниковые лазеры и светодиоды, высокоэффективные фотоприемники и быстродействующие транзисторы стали ключевыми элементами оптических проигрывателей и дисплеев, мобильных телефонов и солнечных батарей, волоконно-оптических линий связи и многих других достижений современной цивилизации.

Действительный член Российской Академии наук, вице-президент РАН, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, директор Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе РАН, член комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации Жорес Иванович Алферов, отпраздновавший в марте этого года свое 70-летие, очень многое успел в науке: он автор более 500 научных работ, в том числе трех монографий, более 50 изобретений. И хотя его достижения уже были отмечены многими престижными премиями, в высшей степени справедливо, что выдающиеся результаты, полученные им в области полупроводниковых гетероструктур, удостоены высшей научной награды – Нобелевской премии.

От имени редсовета, редколлегии и редакции журнала «Квантовая электроника» сердечно поздравляем Жореса Ивановича Алферова со званием лауреата Нобелевской премии!

Н.Г.Басов, О.Н.Крохин